



<b>Title of Change:</b>	Bucheon 8inch FRD rectifiers dual source in CZ4	
<b>Proposed First Ship date:</b>	11 Jan 2021 or earlier if approved by customer	
<b>Contact Information:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <a href="mailto:Daniel.Jeon@onsemi.com">Daniel.Jeon@onsemi.com</a>	
<b>PCN Samples Contact:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < <a href="mailto:PCN.samples@onsemi.com">PCN.samples@onsemi.com</a> >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
<b>Type of Notification:</b>	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPC2N) sent to customers. An IPC2N is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan.The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPC2N notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact < <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a> >	
<b>Marking of Parts/ Traceability of Change:</b>	Affected products will be identified with date code	
<b>Change Category:</b>	Test Change, Wafer Fab Change	
<b>Change Sub-Category(s):</b>	Manufacturing Site Addition	
<b>Sites Affected:</b>		
<b>ON Semiconductor Sites</b>	<b>External Foundry/Subcon Sites</b>	
ON Semiconductor Bucheon, Korea	None	
ON Semiconductor Roznov, Czech Republic		
<b>Description and Purpose:</b>		
Bucheon Korea 8inch FRD rectifier dual source in CZ4 Czech Republic.		
	<b>Before Change Description</b>	<b>After Change Description</b>
Manufacturing locations for Wafer Fab and Probe Test	ON Semiconductor Bucheon, Korea	ON Semiconductor Bucheon, Korea ON Semiconductor Roznov, Czech Republic
There is no product marking change as a result of this change		

**Qualification Plan:**

QV DEVICE NAME: FFA60UA60DN

RRF: 68327, 68386

PACKAGE: TO3P

Device will follow the generic plans shown below:

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C for device, bias = 80% of max rated	1008 hrs
HAST	JESD22-A101	Ta = 130°C, RH=85%, Pressure: 18.8 psig, bias = 100V max	96hrs
H3TRB	JESD22-A101	Temp = +85°C; RH = 85%, 80% rated V or 100V max (JA101)	1008 hrs
UHAST	JESD22-A118	Ta=130°C/85% RH/18.8 PSIG	96hrs
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs
IOL	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, Ton=Toff 5.0 min	6000 cyc
RSH	JESD22- B106	Ta=265°C 10 sec dwell B106	10s
DPA	AEC Q101-004	Post 1008 hours H3TRB (+PC) or 96 hrs HAST (+PC)	
DPA	AEC Q101-004	Post 1000 cyc TC (+PC)	
Tri-Temp		Characterization of all 48A parameters	
ESD	12MSB17722C	HBM, CDM	

QV DEVICE NAME: FFH30S60STU

RRF: 68326, 68387

PACKAGE: TO247

Device will follow the generic plans shown below:

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C for device, bias = 80% of max rated	1008 hrs
HAST	JESD22-A101	Ta = 130°C, RH=85%, Pressure: 18.8 psig, bias = 100V max	96hrs
H3TRB	JESD22-A101	Temp = +85°C; RH = 85%, 80% rated V or 100V max (JA101)	1008 hrs
UHAST	JESD22-A118	Ta=130°C/85% RH/18.8 PSIG	96hrs
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs
IOL	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, Ton=Toff 5.0 min	6000 cyc
RSH	JESD22- B106	Ta=265°C 10 sec dwell B106	10s
DPA	AEC Q101-004	Post 1008 hours H3TRB (+PC) or 96 hrs HAST (+PC)	
DPA	AEC Q101-004	Post 1000 cyc TC (+PC)	
Tri-Temp		Characterization of all 48A parameters	
ESD	12MSB17722C	HBM, CDM	



QV DEVICE NAME : FNA41560T2

RMS: 68142

PACKAGE : SPM45

Test	Specification	Condition	Interval
H3TRB	JESD22-A101	Ta=85°C, RH=85%, Vpn100V, Vcc=20V	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	200 cyc
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig	96 hrs

**Electrical Characteristics Summary**

Electrical characteristics are not impacted

**List of Affected Parts:**

*Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).*

Part Number	Qualification Vehicle
FSB50450AS	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FSB50450BS	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FSB50550BB	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FSBB20CH60C	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FSBB30CH60C	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FNCS1560L	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FNA41560B2	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FNA41560B5	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FNB40560	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FNB41560	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FNC42060F2	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FNC42060F2-Z002	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FNE41060	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

*Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



## 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23428X

発行日: 26 Aug 2020

変更件名:	富川に加えて CZ4 からの 8 インチ FRD レクティブアイヤのデュアルソース化	
初回出荷予定日:	11 Jan 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < Daniel.Jeon@onsemi.com > にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だてて通知されます。ご不明な点がありましたら、< PCN.Support@onsemi.com > にお問い合わせください。	
部品のマーキング/変更のトレーサビリティ:	影響を受ける製品は日付コードで識別されます。	
変更カテゴリ:	検査の変更、ウェハー工場の変更	
変更サブカテゴリ:	製造拠点の追加	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
オン・セミコンダクター 富川、韓国	なし	
オン・セミコンダクター ロジノフ、チェコ共和国		
説明および目的:	8 インチ FRD レクティブアイヤを富川 (韓国) に加えて CZ4 (チェコ共和国) からデュアルソースとします。	
	変更前の表記	変更後の表記
ウェハー工場およびプローブ検査のための製造拠点	オン・セミコンダクター 富川、韓国	オン・セミコンダクター 富川、韓国 オン・セミコンダクター ロジノフ、チェコ共和国
今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。		



## 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23428X

発行日: 26 Aug 2020

## 認定計画:

デバイス名: FFA60UA60DN

RMS: 68327, 68386

パッケージ: TO3P

製品は以下に示す一般的な計画に従います。

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	デバイスの $T_j = 175^\circ\text{C}$ 、バイアス = 最大定格の 80%	1008 時間
HAST	JESD22-A101	$T_a = 130^\circ\text{C}$ 、RH=85%、圧力: 18.8 psig、バイアス = 最大 100V	96 時間
H3TRB	JESD22-A101	温度 = $+85^\circ\text{C}$ 、RH = 85%、80% 定格 V または最大 100V (JA101)	1008 時間
UHAST	JESD22-A118	$T_a=130^\circ\text{C}/85\% \text{ RH}/18.8 \text{ PSIG}$	96 時間
TC	JESD22-A104	$T_a = -55^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$	1000 サイクル
HTSL	JESD22-A103	$T_a = 175^\circ\text{C}$	1008 時間
IOL	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	$T_a=+25^\circ\text{C}$ 、 $\Delta T_j$ =最大 $100^\circ\text{C}$ 、 $T_{on}=T_{off}$ 5.0 分	6000 サイクル
RSH	JESD22- B106	$T_a=265^\circ\text{C}$ 10 秒 滞留 B106	10 秒
DPA	AEC Q101-004	1008 時間 H3TRB (+PC) または 96 時間 HAST (+PC) 後	
DPA	AEC Q101-004	1000 サイクル TC (+PC) 後	
3 温度		全 48A パラメータの特性	
ESD	12MSB17722C	HBM, CDM	

デバイス名: FFH30S60STU

RMS: 68326, 68387

パッケージ: TO247

製品は以下に示す一般的な計画に従います。

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	デバイスの $T_j = 175^\circ\text{C}$ 、バイアス = 最大定格の 80%	1008 時間
HAST	JESD22-A101	$T_a = 130^\circ\text{C}$ 、RH=85%、圧力: 18.8 psig、バイアス = 最大 100V	96 時間
H3TRB	JESD22-A101	温度 = $+85^\circ\text{C}$ 、RH = 85%、80% 定格 V または最大 100V (JA101)	1008 時間
UHAST	JESD22-A118	$T_a=130^\circ\text{C}/85\% \text{ RH}/18.8 \text{ PSIG}$	96 時間
TC	JESD22-A104	$T_a = -55^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$	1000 サイクル
HTSL	JESD22-A103	$T_a = 175^\circ\text{C}$	1008 時間
IOL	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	$T_a=+25^\circ\text{C}$ 、 $\Delta T_j$ =最大 $100^\circ\text{C}$ 、 $T_{on}=T_{off}$ 5.0 分	6000 サイクル
RSH	JESD22- B106	$T_a=265^\circ\text{C}$ 10 秒 滞留 B106	10 秒
DPA	AEC Q101-004	1008 時間 H3TRB (+PC) または 96 時間 HAST (+PC) 後	
DPA	AEC Q101-004	1000 サイクル TC (+PC) 後	
Tri-Temp		全 48A パラメータの特性	
ESD	12MSB17722C	HBM, CDM	



## 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23428X

発行日: 26 Aug 2020

デバイス名: FNA41560T2

RMS: 68142

パッケージ: SPM45

テスト	規格	条件	間隔
H3TRB	JESD22-A101	Ta=85°C, RH=85%, Vpn100V, Vcc=20V	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	200 cyc
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig	96 hrs

## 電気的特性の要約

電気的特性に影響はありません

## 影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
FSB50450AS	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FSB50450BS	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FSB50550BB	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FSBB20CH60C	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FSBB30CH60C	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FNCS1560L	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FNA41560B2	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FNA41560B5	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FNB40560	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FNB41560	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FNC42060F2	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FNC42060F2-Z002	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2
FNE41060	FFA60UA60DN, FFH30S60STU, FNA41560T2